KOREAN PATENT ABSTRACT (KR)

PUBLICATION

(51) IPC Code: C08G 73/10, G02F 1/00

(11) Publication No.: 10-0169910 (24) Publication Date: 13 October 1998 (21) Application No.: 10-1996-020080 (22) Application Date: 05 June 1996

(73) Patentee:

Electronics and Telecommunications Research Institute, Seung-tack Yang 161 Gajeong-dong, Yuseong-gu, Daejeon

Korea Telecom, Jun Lee 100 Sejongno, Jongno-gu, Seoul

(72) Inventors:

Hyeng-jong Lee Wooseung Apt. 101-304, Doryong-dong, Yuseong-gu, Daejeon

Myeong-hyeon Lee Hanvit Apt. 120-1306, Eoeun-dong, Yuseong-gu, Daejeon

Seon-gyu Han Crover Apt. 115-406, Dunsan-dong, Seo-gu, Daejeon

Yong-hyeop Won Narae Apt. 109-506, Jeonmin-dong, Yuseong-gu, Daejeon

(54) Title of the Invention:

Nonlinear optical polyimide, preparation method therefor, and waveguide type photodiode using the nonlinear optical polyimide

Abstract:

Provided are a nonlinear optical polyimide represented by the formula (1) or (2), a preparation method therefor, and a waveguide type photodiode including a core layer made of the nonlinear optical polyimide represented by the formula (1) or (2). In the formulae (1) and (2), n is a length of a flexible group selected from the natural numbers of 2 to 10; X is $C(CF_3)_2$, $C(CH_3)_2$, $Si(CH_3)_2$, CO, SO_2 , CO, or CO, or CO is an electron donor group selected from CO, CO,

母0169910

(18) 대한민국특허청(KR) (12) 등목특허공보(B1)

(51) Int. CI. ⁶		(45) 공고일자	1999년03월20일
COBG 73/10		(11) 등록번호	粤0169910
602F 1/00		(24) 등록일자	1996년 10월 13일
(21) 출원번호	星1996-020080	(65) 공개번호	昌1998-002108
(22) 출원일자	1996년06월05일	(43) 공개일자	1998년 03월 30일
(73) 특허권자	한국전자통신연구소 양	승택	
	대전광역시 유성구 가정동	161번지한국전기룡신공시	l 이준
(72) 발명자	서울특별시 중로구 세중로 이형중	100번지	
	대전광역시 유성구 도룡동 이명현	우성아파트 101-304	
	대전광역시 유성구 어른동 한선규	한빛아파트 120-1306	
	대진광역시 서구 문산동 크 원용협	1로바아파트 115-406	
(74) 대리인	대전광역시 유성구 전민동 김영길, 원혜중, 김명섭.	나레아파트 109-506	

성사관 : 김흥권

(54) 비선형 광학 졸리이이드, 그의 제조방법 및 전기한 비선형 광학 졸리이미드를 사용한 광도파로형 광소자

ድ୍

본 발명은 하기 일반식 (1)및 (2)로 표시되는 비선형 광학 졸리이미드, 그의제조방법 및 하기 일반식 (1) 및 (2)로 표시되는 비선형 광학 졸리이미드를 코어츙으로서 사용한 광도파로형 광소자에 관한 것이다.

실기 석에서 1은 유변기의 길이로서, 2대지 10의 자연수이고;X는 C(CF₁)₂, C(CM₁)₂, Si(CM₁)₂, CO, CO₂, 0 및 SOID:O는 전자주게기로, 0, NH및 일킬이만(N-R₁, OHM R₂은 CHM지 CA의 알킬기)이고:8는 연결기로 아무것도 없거나, CH=CH, N=N, C=COID:A는 전자받게기로, NO₂, 트라시아노에틸렌, CM, SO₂R₂(OHM,R₂는 CHM CA의 알킬기)이고: 및, Y는 C(CF₁)₂, C(CM₁)₂, Si(CM₁)₂, CO, SO₂, O및 SOICH.

BANE

[발명의 명칭]

비선형 광항 즐리이미드, 그의 제조방법 및 전기한 비선형 광학 졸리이미드를 사용한 광도파로형 광소자 [발명의 상세한 설명]

본 발명은 비선형 광항 즐리이미드, 그의 제조방법 및 전기한 비선형 광항 즐리이미드를 사용한 광도파로 형 광소자에 관한 것이다. 좀더 구체적으로 본 발명은 축쇄(side-chain)비선형 광학 방향족(sromotic)뜰 리이미드, 그의 제조방법, 및 전기한 비선형 광학 플리이미드를 사용하여 고속 광변조기, 광스위치, 이차 조화파 발생기 편광 평터 및 파장 팔터 등과 같은 광소자를 제조하는 것에 관한 것이다.

최근, 정보통신분야에서 광대역, 고속 및 고집적화 등에 대한 요구가 증대되고 있으나, 이에대한 순수 전 자회로와 전송시스템의 한계 때문에 정보통신기술에서 광의 역합이 점차 증가하고 있는 추세에 있다. 이 와관련하여 장거리 전송용 광성유를 시작하며, 광변조기, 광스위치 등이 바른 속도로 개발되고 있다. 현 재까지, 이러한 광소자의 재료율질로서 반도체 재료인 BaAs 및 무기, 유기율 모두가 연구되어 왔다. 미중에서도, 유기 광진자 고본자물질은 황-진자 메카니즘의 고유한 차이(강자성 결정인 무기룡은 미율의 광-전자반용이 미온치환에 좌우되는 반면에, 유기 광진자 재료는 광-전자반용이 제개 구조의 전자구조의 변화에서 기민한다)대문에, 유기 광진자 고본자물질은 리를 니오베이트(LiMu3)와 반도체 물질에 비하며, 교환(switchine)숙도가 때우 빠르고(50 picosec vs. 2 manosec), 광대역 쪽이 아주높다(100명년)는 장점을 지니고 있다. 또한 유기 광진자 고본자물질은 가공성이 우수하기 때문에, 다양한 공소자, 예를 들면, 적 전 광도파로 배선, 위상 변조기, 마하-젠다(Mach-Zehnder)간성계, 빔 스프리터(beam splitter), 방향성 검합기(directional coupler) X-스위치 (X-switch)등에의 집적화가 매우 용이하여 차세대 정보 통신에 필요한 광소자에 매우 유리하다는 장점을 지지고 있다.

이러한 유기 고분자종질로 제조된 광소자의 실용화를 위하여 해결되어야 할 과제는 큰 전기광학계수, 낮은 광전승손실, 및 열적안정성을 들 수 있다.

상기한 유기 광전자 고분자롭질 중에서도, 광전자 유기롭을 고분자의 주쇄에 유연기를 이용하여 공유결합 시킨 욕쇄 고분자는 매우 흥미로운 광학특성을 나타내는 새로운 중류의 유기출점이다.

현재까지 개발된 마크립레이트계 축쇄 비선형 황항 고분자는 큰 전기광학계수와 우수한 필흡 특성으로 인 하여 낮은 광전송손실을 나타내지만, 이를 고분자의 유리전이온도(glass transition temperature)가 150 ℃이하로 소자 제작시 요구되는 열적안전성이 떨어진다는 단점을 지니고 있었다.

상기한 열쩍 안정성을 개선하기 위하며, 최근에는 유리전이온도가 200c이상인 즐리이미드계 비선형 광학 고분자가 개합되었다. 이러한 즐리미미드계 축쇄 비선형 광학 고분자의 제조방법은 크게 3가지로 구분된 다.

첫째는, 비선형 광학 크로모포(chromophore)가 공유결합된 방향즉디아민(diamine) 모노대를 합성한 다음, 이룹 방향즉 디언하이드라이드(diambdride)와 중합하여 흑쇄 비선형 광학 즐리이미드를 얻는 방법이다. 두 번째는, 비선형 광학 크로모포가 공유결합된 방향즉 디언하이드라이드를 합성한 다음, 이를 방향즉 디아민과 중합하여 흑쇄 비선형 광학 즐리이미드를 제조하는 방법이다.

그러나, 이를 방법은 크로모포 합량 조절의 용이성은 있으나, 크로모포가 공유결합된 모노대의 합성이 난해하고, 이미드화 반응 중에 열에 약한 크로모포의 손상이 일어난다는 단점을 지니고 있었다.

한편, 세 번째 방법은, 페뉼릭 하이드록시(phenolic hydroxy)기를 가진 디아민 모노마와 방향즉 디언하이 드라이드를 먼저 중합하며 폴리머 주쇄에 페뇰릭 하이드록시기를 가진 폴라이미드를 합성한 다음, 이를 크로모포 분자와 폴리머 반응을 통하여 폴리이미드 주쇄에 공유결합시키는 방법이다.

상기한 방법은 합성의 용미성과 다양한 크로모포의 도입이 가능하다는 점에서 커다란 장점을 지니고 있으나, 일반적으로 페뉼릭 하이드록시기를 지닌 디어만은 극소수를 제외하고는 대기 중에서 때우 물안정하기때문에, 쉽게 산화되어 모노대로서의 사용이 불가능하다는 결정적인 문제점을 지니고 있었다.

결국, 본 발명은 상기한 증래기술의 문제점을 해결하기 위하여 안출한 것으로, 본 발명의 주된 목적은 다 양한 크로모포를 도입할 수 있고, 열적으로 때무 안정하면서, 가공성과 필름특성 및 박막특성이 우수한 동시에, 큰 전기광하계수를 지닌 신규한 비선형 광학 즐리미미드를 제공함에 있다.

본 발명의 다른 목적은 증래기술에서와 같은 디아민 산화가능성을 완전히 배제하면서, 합성의 용이성 및 다양한 크로모포의 도입 가능성 등과 같은 장점을 그대로 유지할 수 있는 비선형 광항 폴리이미드의 제조 방법을 제공함에 있다.

본 발명의 또다른 목적은 상기한 본 발명의 비선형 광학 출리이미드를 채용함으로써, 낮은 구동전압에서 도 구동가능하고, 광전손 손실이 매우 낮은 신뢰성이 우수한 광도파로형 광소자를 제공함에 있다.

상기한 본 발명의 목적은 다양한 폐들릭 하이드록시기를 지닌 디아만 디하이드로클로라이드염을 모노대로 사용함으로써 달성될 수 있다.

상기한 본 발명의 목적을 달성하는, 본 발명의 일면에 따른 방향족 폴리이미드계 측쇄 비선형 광학 폴리머는, 하기 일반식(1)로 표시된다.

承母41

Ö

상기 석에서, n은 유연기의 필이로서, 2 내지 10의 자연수이고; X는 C(CF₄), C(CH₃), C0, S0, 0 및 S0 고 : II는 전자주게기(electron donor group)로, 0, MI 및 알릴이민(M-R₁, 이때 R-은 C 내지 C의 알릴기) 이고 : B는 연결기(bridging group)로 마무것도 없거나, CM-CH, NH, C-COI고; 및, A는 전자받게기(electron acceptor group)로, NG, 트리시 마노메틸랜(tricyanosthylene), CH, SQR(이때, R-는 C, 내지 C의 알립기)이다.

또한, 본 발명의 또 다른 일면에 따른 방향즉 출리이미드계 속쇄 비선형 광학 즐리대는, 하기 일반석(2)로 표시된다.

좌 투식 2

상기식에서, n, X, D, B 및 A는 삼기 기재와 동일하고: 및, ∀는 C(CF_e)₂, C(CH_e)₂, Si(OH_e)₂, CD, SO₂, D 및 SOICE.

상기 일반식(1) 및 (2)로 표시되는 본 발명의 비선형 광학 졸리미미드는, 유리전미돈도가 200℃이상으로 열적으로 매우 안정하며, 우수한 가공성과 필름 특성 및 매우 큰 전기광학계수를 지니며, 특히, 엄반식(2)로 표시되는 비선형 광학 졸리이미드는 단위 모노대당 2개의 크로모포를 함유하기 때문에, 더욱 항상된 전기광학계수를 지녀, 신뢰도가 보다 우수한 광전자소자를 제조하는데 효과적으로 사용될 수 있다.

한편, 본 발명의 일면에 따른 상기 일반식(1)로 표시되는 비선형 광학 졸리미미드의 제조방법은, 방향즉 디언하이드라이드 유도체와 디아미노 페늄 디하이드로클로라이드(diamino phenol dihydrochloride)화합률 을 열측중합반용시켜 퍼造릭 하이드록시기를 지닌 즐리이미드를 제조하는 단계와, 상기한 페놀릭 하이드 록시기를 지닌 폴리이미드의 주쇄에 크로모포 화합물을 공유결합시켜 비선형 광학 폴리이미드를 제조하는 단계를 포함한다.

또한 본 말명의 다른 일면에 따른 상기 일반식(2)로 표시되는 비선형 황학 폴리이미드의 제조방법은, 방향적 디언하이드라이드 유도체와 디어미노 디페늄 디하이드로블로라이드(diamino diphenol dihydrochloride)유도체를 열측중합반용시켜 디페늄릭 디하이드록시기를 지닌 폴리이미드를 제조하는 단계와, 상기한 디페늄릭 디하이드록시기를 지난 폴리이미드의 주쇄에 크로모포 화합물을 공유결합시켜 비선형 광학 폴리이미드를 제조하는 단계를 포함한다.

[반응도식 1]

이중에서, 상기 일반식(1)로 표시되는 본 발명의 방향즉 플리이미드계 축쇄 비선형 광학 플리머의 제조방 범의 일레를 상출하면 다음과 같다. 먼저, 다양한 치환기를 지난 방향즉 디언하이드라이드 유도체와 디아 미노 메월 디하이드로클로라이드엄을 유기용매의 존재하에서 150-180°C의 고온에서 중합반용 및 이미드화 반응을 동시에 일어나게 하여 퍼뉼릭 하이드록시기를 지난 플리이미드를 제조한다. 다음에 이 플리머와 4-(하미드록시 엄윌아미노)-4·니트로 스틸벤 등과 같은 다양한 비선형 광학 크로모포 화합물과 트리퍼날 포스핀을 THT나 NP(H-메틸피롤리디논) 등의 유기용매에 용해시킨후, 이 용액에 THF 등의 유기용매에 묽한 디메틸 마조디카르복실레이트 (diethyl ezodicarboxylate)를 서서히 적하하며 미즈노부반응에 의해 상 기한 플리머 주쇄에 크로모포 화합물을 공유결합시킴으로써, 본 발명의 비선형 광학 플리이미드를 얻는

상기한 일반식(1)로 표시되는 본 발명의 비선형 광학 폴리이미드의 제조과정을 하기 반응도식(+)에 예시 적으로 나타내었다. 世春41

한편, 상기 일반식(2)로 표시되는 본 발명의 방향즉 플라이미드계측쇄 비견형 광학 폴리머의 제조방법의 일례를 상용하면 다음과 같다. 먼저, 옥시 디어미노 디페날 디하미드로를로라이드염과 같이 단위 모노머 당 2개의 하미드록시를 지난 다양한 치환기를 갖는 디어미노 디페놀 디하미드로 클로라이드 유도체와 다 양한 치환기를 지난 방향즉 디언하이드라이드 유도체를 유기용때의 존재하에서 150-180[°]C의 고온에서 중 합반응 및 이미드화반응을 동시에 일어나게 하여 디페뉼릭 디하미드록시기를 지난 폴라이미드를 제조한 다. 그후, 미 폴리머와 2m이의 4-(하미드록시 알릴아미노)-4^{*}-나트로스틸벤과 같은 다양한 비전형 광학 물로모포 화합물 및 트리페널 포스핀을 TM나 NAP 등의 유기용때에 용해시킨 후, 이 용액에 TMF 등의 유 기용때에 묽힌 디에틸 아조디카르복실레이트를 서서히 적하하여 미즈노부반응에 의해 상기한 폴리머 주쇄 에 크로모포 화합물을 공유결합시킴으로써, 본 발명의 비전형 광학 플리미미드를 얻는다.

상기 일반식(2)로 표시되는 본 발명의 비선형 광학 폴리이미드의 제조과정을 하기 반응도식(II)에 예시적으로 다틴내었다.

世番42

ن

마옵러, 상기한 목적을 달성하는 본 발명의 일면에 따른 광도파로형 광소자는, 실리몬기판 상에 형성된 하부전극과, 상기한 하부전극 상에 형성된 하부 클래딩(cladding)층과, 상기한 하부 클래딩총 상에 형성 된 코어(core)층과, 상기한 코어총 상에 형성된 상부 틀래딩층과, 상기한 상부 클래딩층 상에 형성된 상 부 전국을 포함하는 광도파로형 광소자에 있어서, 상기한 코어총으로는 상기 일반식(1)로 표시도는 비선 형 광학 플리미미드를 사용한 것을 특징으로 한다.

또한, 본 발명의 또 다른 일면에 따른 광도파로형 광소자는, 실리콘기판 상에 형성된 하부전국과, 상기한 하부전국 상에 형성된 하부 클래딩층과, 상기한 하부 클래딩층 상에 형성된 코머총과, 상기한 코머층 상 에 형성된 상부 클래딩층과, 상기한 상부 클래딩층 상에 형성된 상부 전국를 포함하는 광도파로형 광소자 에 있어서, 상기한 코머층으로는 상기 일반석(2)로 표시되는 비선형 광학 플리이미드를 자용한 것을 특징 으로 한다.

이하, 본 발명의 바람작한 설시예를 통하여 본 발명을 더욱 구체적으로 설명하고자 한다. 이를 설시예는 본 발명을 예시하기 위해 주어진 것으로, 본 발명의 범위가 이를 설시예에 의해 제한되지 않는다는 것은 본 발명이 속한 기술분이의 당업자에게 있어서 자명할 것이다.

[실시에 1]

방향주 디언하이드라이드 유도체와 디아미노페늄 디하이드로뮬로라이드영과의 중함에

(가) 4.4'-(핵사출무오로이소프로띨리덴)디프탈릭 언하이드라이드(6FDA)와 2.4-디아미노페늄 CIB어이드로 클로라이드(DAP)와의 중함

50mL 3구 즐라스크에 1.33g(6.75mmole)의 2.4~[IOPI]노페뉼 [I하이드로블로라이드와 3.0g(6.75mmole)의 4.4-(핵사출무오로이소프로필리덴)[디프탈릭 언하이드라이드를 넣고, 전체 농도가 20vt%가 되도록 80:20(v/v)의 사-메틸피롭리[디논(NP)과 디뮬로로벤젠율 주사기를 통해 가하였다. 단-스타크 트램(Dean-Stark trap)를 사용하며 반용 중에 생성되는 물을 제거하면서, 반용온도를 175°C로 몰리고 질소를 계속 끌려주었다. 이후, 정도변화를 관합하면서 약 3-4시간 동안 반응시킨 후, 온도를 내리고 34째의 NBP를 참가하였다. 과랑의 메탄을 반응 혼합물을 천천히 참전시킨 후, 얻어진 고분자를 여과하고 속실렛 추줍기(Soxiet's extractor)로 24시간동안 세척해주었다. 그후, 100°C의 오븐에서 12시간 동안 건조하여 poly(6FDA-DAP)를 수득하였다. 수독한 생성물에 대하면 제재 분석을 수행하였으며, 그 결과를 하기에 나타

내었다.

انة

 1 H-NAR(DMSO_{dro}): 6: 7.07(d, 1H) 7.32(s, 1H), 7.36(d, 1H), 7.72(d of d, 2H), 7.89(d, 2H), 8.11(d, 2H), 10.26(s, 1H)

(나) 3,3',4,4'-육시디프탈릭 언용테드라이트(ODPA)와 2,4-디아미노페늄 디용이트로클로라이트(DAP)와의 중합

50ml의 3구 클라스릭에 1.18g(6.0mmole)의 2.4-디아미노퍼널 디하이드로컬로라이드와 1.86g(6.0mmole)의 3.3",4.4"-옥시디프탈릭 언하이드라이드를 넣고, 전체 농도가 20et와 되게 80:20(v/v)의 바레틸피톨리디논(NP)과 디플로로벤젠를 주사기를 통해 가하였다. 단-스타크 트랩플 미용하여 반용 중에 생성되는 털을 제거하면서, 반용온도를 1750로 올리고 결소를 계속 즐려주었다. 이후, 정도변화를 관심하면서, 약 3-4 시간동안 반응시킨 후, 온도를 내리고 34点의 NP를 참가하였다. 과랑의 메단율에 반응 혼합물을 천천하 참진시킨 다음, 얻어진 고분자를 여괴하고, 속실럿 추출기로 24시간 동안 세척하여 주었다. 그후, 1000억 오본에서 12시간 동안 건조하여 poly(CDPA-DAP)를 수독하였다. 수독한 생성물에 대하여 NPR 분석을 수행하였으며, 그 결과를 하기에 나타내었다.

 $^{\text{h-NHR}(DKSQ}_{-6})$: 5 : 7.16(d, 1H) 7.43(s, 1H), 7.44(d, 1H), 7.66(d of d, 2H), 7.71(d, 2H), 8.10(d, 2H), 10.36(s, 1H)

[실시에 2]

방향족 다던하이드라이드 유도체와 다이미노 다페늄 다하이드로클로라이드염 유도체와의 중함에

(가) 4,4'-(핵사율투오로이소프로필리덴)디프탈릭 언하이드라이드와 3,3'-디아미노-4,4'-육시디페旨 디하 이드로클로라이드와의 중합

디아민영으로 2.4-디아미노패늄 디하이드로클로라이드 대신에 3.3'-디아미노-4.4'-옥시디페늄 디하이드로 클로라이드를 사용한 것을 제외하고는, 상기 실시예 1의 (가)와 동일하게 실시하였다.

(나) 3,3',4,4'-목시디프탈릭 연하이드라이드(OOPA)와 3,3'-디아미노-4,4'-목시디페뇰 디하이드로클로라이드와의 중합

디아민영으로 2,4-디아미노페들 디하이트로클로라이드 대신에 3,3'-디아미노-4,4'-옥시디페들 디하이트로 클로라이드를 사용한 것을 제외하고는, 상기 실시에 1의 (나)와 동일하게 실시하였다.

1실시에 31

료통력 하이드록시기를 지닌 졸라이미드에 크로모포를 미즈노부 반응에 의해 공유결합시켜 졸리이미드계 축쇄 비선형 광학 졸리머를 제조한 제조예

(가) poly(6FDA-DAP)와 디스퍼스 레드1(DR 1)과의 공유결합

50mL 3구 플라스크에 시판되는 비선형 광학 크로모포인 0.67g(2.12mmole)의 디스퍼스 레드 1(disperse red 1)과 0.61g(2.33mmole)의 트리 페닐 포스핀과, 상기 실시예 1의 (가)에서 수독한 poly(GFDA-DAP) 1g(1.92mmole)을 넣고, 35mm의 THF 용매로 완전히 용해시켰다. 5분 후에 이 반응용기에, 2mm의 THF에 0.41g(2.33mmole)의 디에틸 아조디카르록실레이트를 녹인 용액을 천천히 적하하였다. 적하가 진행됨에 따라, 반응 혼합물이 점차로 고체화되었다. 이 반용 혼합물을 상은에서 3시간 동안 교반하여 다시 투명한 음액으로 만들었다. 상은에서 23시간 동안 더 교반시킨후, 반응 혼합물을 거-영산 10ml가 참가된 250ml의 메탄을 내에서 서서히 참진시켰다. 얻어진 플리머를 다시 THF에 용해시킨 후, 재차 2N-영산 10ml가 참가된 250ml의 메탄을 대에서 서서히 참진시켰다. 얻어진 플리머를 다시 THF에 용해시킨 후, 재차 2N-영산 10ml가 참가된 250ml의 메탄을 중에서 서서히 참진시켰다. 얻어진 플리머를 여과한 후, 속실렛 추출기로 24시간 동안 세척한 후, 100°C의 진공오본에서 24시간 동안 건조시켜, 본 말명의 비선형 광학 플리머인 poly(GFDA-DAP-DRI)을 수독하였다. 수독한 생성물에 대하여 NMR 본석을 수행하였으며, 그 결과를 하기에 나타내었다.

 $^{\text{H-NMR}(DNSQ_{-6})}$: 6 : 0.91(3H) 3.30(2H), 3.78(2H), 4.37(2H), 6.76(2H), 7.45(1H), 7.61(3H), 7.75(2H) 7.89(4H), 8.16(2H), 8.32(2H)

(LI), poly(00PA-0AP)와 디스퍼스 레드 1(0R1)과의 공유결합

50ml 3구 플라스크에 0.44g(1.38mmole)의 디스퍼스 레드 1과 0.73g (2.76mmole)의 트리페닐 포스핀과, 상기 실시에 1의 (나)에서 수독한 poly(00PA-DAP)를 넣고, 20ml의 NMP 용매로 완전히 용해시켰다. 5분 후에, 이 반용용기에 2ml의 NMP에 0.48g(2.76mmole)의 디에틸 아조디카르복실레이트를 녹인 용액을 천천히 적하시켰다. 적하기 진행팀에 따라, 반용 혼합물이 점차로 고체화되었다. 이 반응 혼합물을 50°C에서 3시간 동안 교반하여 다시 투명한 용액으로 만들었다. 50°C에서 23시간 동안 더 교반한 후, 반응 혼합물을 2N-검산 10ml가 참가된 250ml의 메탄을 중에서 서서히 참전시켰다. 얻어진 즐리머를 다시 NMP에 용해시킨후, 재차 2N-검산 10ml가 참가된 250ml의 메탄을 중에서 서서히 참전시켰다. 얻어진 즐리머를 다시 NMP에 용해시킨후, 재차 2N-검산 10ml가 참가된 250ml의 메탄을 중에서 서서히 참전시켰다. 얻어진 즐리머를 다시 NMP에 용해시킨후, 재차 2N-검산 10ml가 참가된 250ml의 메탄을 중에서 서서히 참전시켰다. 얻어진 즐리머를 다시 NMP에 용해시킨후, 재차 2N-검산 10ml가 참가된 250ml의 매탄을 중에서 서서히 참전시켰다. 얻어진 즐리머를 다시 NMP에 달해시킨후, 예수성 추줍기로 24시간 동안 세척시킨후, 100°C의 진공오본에서 24시간 동안 건조하여 본 발명의 비선형 광학 즐리머인 poly(00PA-DAP-0RI)을 수독하였다. 수독한 생성물에 대하여 NMR 본석을 수 행하였으며 그 결과를 하기에 나온내었다.

'H-NMR(DMSOG-6): 6 : 1.03(3H), 3.30(2H), 3.79(2H), 4.34(2H), 6.76(2H), 7.40(7H), 7.61(4H), 7.91(3H), 8.06(2H), 8.32(2H)

(CL) poly(6FDA-DAP)와 4-(N-메틸-2-하이드록시에틸아테노)-4'-니트로 스틸벤(DANS)과의 공유함한

50mL 3구 중라스크에 비선형 광학 크로모포로서 0.32g(1.06mmole)의 4-(N-메립-2-하이드록시에틸아미노)-4'-니트로 스틸벤과 0.56g(2.12mmole)의 트리패널 포스핀과, 상기 설시에 1의 (가)에서 수독한 poly(6FDA-DAP) 0.5g(0.96mmole)을 넣고, 25mL의 THF 용매로 완전히 용해시켰다.

5분 후에, 이 반응용기에 5ml의 THF에 0.37g(2.12mmole)의 디에틸 아조디카 르복실레이트를 녹인 용액을 천천히 적하시켰다. 적하가 진행됨에 따라, 반응 혼합물이 점차로 고체화되었다. 이 반용 혼합물을 상은에서 3시간 동안 교반하여 다시 투명한 용액으로 만들었다. 상은에서 23시간 동안 더 교반한 후, 반용 혼합물을 24-영산 10ml가 참가된 250ml의 메탄을 중에서 서서히 참전시켰다 얻어진 플리머를 다시 THF에 용해시킨 후, 재차 24-영산 10ml가 참가된 250ml의 메탄을 중에서 서서히 참전시켰다. 얻어진 플리머를 여 과한 후, 속실렛 추즐기로 24시간 동안 세척시킨 후, 100°C의 진공오븐에서 24시간동안 건조하여 본 발명의 광학 즐리머인 poly(GFDA-DAP-DANS)를 수득하였다.

(라) poly(ODPA-DAP)와 4-(N-메틸-2-하이드록시메틸마미노)-4'-LI트로 스틸벤(DANS)과의 공유결합

크로모포로서, 디스퍼스 레드 1 대신에 4-(N-메틸-2-하이드록시메틸아미노)-4'-니트로 스틸벤을 사용한 것을 제외하고는, 상기 실시에 3의 (나)와 동일하게 살시하며 본 말명의 비선형 광학 즐리머인 poly(ODPA-DAP-DANS)을 수독하였다.

[실시예 4]

본 발명의 폴리머를 미용한 광소자의 제조예

(가) poly(GFDA-DAP-DRI)을 미용한 광소자의 제조

상기 실시에 3의 (가)에서 수독한 poly(6FDA-DAP-DRI)을 20wtX가 되도록 C-부터로락본(butyrolactore)에 용해시킨 후, 0.2Lm의 테프론 팔터를 사용하여 여과하였다. 한편, 기존에 시판되는 폴리이미드를 사전에 금(Au)이 증착된 실리콘 기판 상에 주사한 후, 스핀코팅하여 광도파로의 하부 클래딩(cladding)총을 형성하였다. 이때, 하부 클래딩총의 두메는 스핀코팅시 회전수의 조정에 의해 조절되며, 그 총의 두메는 회전수에 반비례한다. 얻어진 하부 클래딩총을 250°C의 오븐 내에서 5시간 동안 방치하였다. 클래딩총 위에고어(core)총을 형성하기 위하여, 여과에 의해 얻어진 상기한 poly(6FDA-DAP-DRI) 용액을 스핀코팅한 후, 100°C의 오븐에서 2시간 및 160°C의 오븐에서 2시간 동안 방치한 후, 얻어진 박막 형태의 코어총을 광표백(photobleaching)법을 사용하여 도파로의 측면 구속(confinement)을 수행하였다. 제조된 코더총 위에 기존에 시판되는 폴리더로 상부 클래딩총을 형성하기 위하여 스핀 코팅하였다. 그후, 상부 전극을 형성하기 위하여, 박악위에 금을 진공증착하고, 최대의 전기광학효과를 얻기 위하여 극화(poling)시켰다. 이때, 극화는 150~250°C의 핫 플레이트(hot plate) 상에 실리콘 기판을 배치시키고, 실리콘 기판 상의 하부 전 극과 고본자 박악 상의 상부 전극 사이에 Lm당 100~200V의 강한 직류전압을 기합으로써 미루어졌다. 극화 가 미루어진 후, 상부 전극을 통상적인 미세가공 기술을 이용하여 도파로를 따라 식각하여 본 발명의 광도파로형 광소자를 제조하였다.

(LL)poly(ODPA-DAP-DRI)을 이용한 광소자의 제조

비선형 광학 졸리머로서, poly(6FDA-DAP-DRI) 대신에 poly(DDPA-DAP-DRI)를 사용한 것 이외에는 상기 실시에 4의 (가)와 동일하게 실시하여 본 발명의 광도파로형 광소자를 제조하였다.

(다) poly(6FDA-DAP-DRI)를 이용한 광소자의 제조

비선형 광학 폴리머로서, poly(6FDA-DAP-DR1) 대신에 poly(6DPA-DAP-DR1)를 사용한 것 이외에는 상기 실 시예 4의 (가)와 동일하게 실시하여 본 발명의 광도파로형 광소자를 제조하였다.

(라)poly(ODPA-DAP-ORI)를 이용한 광소자의 제조

비선형 광학 폴리머로서, poly(60FA-DAP-DRI) 대신에 poly(0DPA-DAP-DRI)를 사용한 것 이외에는 상기 실시에 4의 (가)와 동일하게 실시하여 본 발명의 광도파로형 광소자를 제조하였다.

상기한 본 발명의 제조방법에 따라, 매우 큰 값의 전기광학계수를 지녀 전기광학특성이 매우 우수하고, 박막 특성이 우수하며 다층 박막의 형성이 용이하여 신뢰성을 중대시킬 수 있음은 물론, 열적 안정성이 극히 우수하여 250°C 이상의 온도에서도 열적으로 분해와 승화가 일머나지 않으며, 200°C 이상의 온도에 서도 쌍극자의 완화현상이 일머나지 않는 비선형 광학 즐리머를 얻을 수 있으며, 본 발명의 버선형 광학 즐리머를 사용하여 낮은 구동 전압에서도 구동가능한 동시에 광전송 손실이 매우 낮은 광소자를 제조할 수 있다.

(57) 경구의 범위

청구함 1

하기 일반식(1)로 표시되는 비선형 광학 중리이미드 :

상기 식에서 n은 유연기의 립이로서, 2 내지 10의 자연수이고; X는 C(OF₄)₂, C(OH₄)₂, C(OH₄)₂, SI(OH₄)₂, OO, SO₂, O 및 SOI고, D는 전자주게기로, O, MH 및 알립이민(N-R₄, OI때 R₄은 C, 내지 C₄의 알립기)이고; B는 연결기로 아무것도 없거나, CH=CH, N=N, C=COI고; 및, A는 전자받게기로, NO₂, 트리시아노메틸렌, CH, SO₂R₄(OI때, R₅는 C, 내지 C₄의 알립기)이다.

청구함 2

하기 일반식(2)로 표시되는 비선형 광학 플리이미드:

상기식에서 $[n, X, D, B 및 A는 제1항 기재와 동일하고; 및 Y는 <math>C(CF_{\bullet})_2$, $C(CH_{\bullet})_2$, $C(CH_{\bullet})_2$, $Si(CH_{\bullet})_2$, CCH_{\bullet} , $Si(CH_{\bullet})_2$, CCH_{\bullet} , $Si(CH_{\bullet})_2$

원구함 3

방향즉 디언하이드리이드 유도체와 디아미노 페뉼 디하이드로를로라이드 화합물을 열측증합반응시켜 페뉼 릭 하이드록시기를 지닌 쫄리이미드를 제조하는 단계와, 상기한 페뉼릭 하이드록시기를 지닌 쫄리이미드 의 주쇄에 크로모포 화합물을 공유결합시켜 비선형 광학 쫄리이미드를 제조하는 단계를 포함하는 하기 일 반식(1)로 표시되는 비선형 광학 좁리이미드의 제조방법:

상기 식에서 n, X, D, B 및 A는 제1항 기재와 동일하다.

청구함 4

방향즉 디언하이드라이드 유도체와 디아미노 디페뇰 디하이드로를로라이드 유도체를 열측증합반응시켜 디 페블릭 디하이드릭시기를 지닌 출리이미드를 제조하는 단계와, 상기한 디페뇰릭 디하이드록시기를 지난 즐리이미드의 주쇄에 크로모포화합물을 공유결합시켜 비선형 광학 즐리이미드를 제조하는 단계를 포함하는 하기 일반식(2)로 표시되는 비선형 광학 즐리이미드의 제조방법 :

상기 식에서 n, X, D, B 및 A는 제1항 기재와 동일하고; 및 Y는 제2항 기재와 동일하다.

청구항 5

실리콘기판 상에 형성된 하부전국과, 상기한 하부전국 상에 험성된 하부 율래당층과, 상기한 하부 뮬래당 층 상에 형성된 교어층과, 상기한 고어층상에 형성된 상부 뮬래당층과, 상기한 상부 뮬래당층 상에 험성 된 상부 전국을 포함하는 광도파로형 광소자에 있어서, 상기한 교어층으로는 하기 일반식(1)로 표시되는 비선형 광학 폴리이마드를 사용한 것을 특장으로 하는 광도파로형 광소자 :

상기 식에서 n, X, D, B 및 A는 제1항 기재와 동일하다.

원구함 6

실리콘기판 상에 형성된 하부전국과, 상기한 하부전국 상에 험성된 하부 클래딩용과, 상기한 하부 클래딩용 상에 형성된 코어용과, 상기한 코머용상에 형성된 상부 클래딩용과, 상기한 상부 플래딩용 상에 형성된 상부 전국을 포함하는 광도따로형 광소자에 있어서, 상기한 코머용으로는 하기 일반석(2)로 표시되는 비선형 광학 즐리이미드를 사용한 것을 특징으로 하는 광도따로형 광소자 :

상기 식에서 n, X, D, B 및 A는 제1항 기재와 동일하고; 및, Y는 제 2항 기재와 동일하다.

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

I	Defects in the images include but are not limited to the items checked:
	□ BLACK BORDERS
	☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
	Q FADED TEXT OR DRAWING
	DECURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
	☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
	COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
	☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
	☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
	☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
	OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.